

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель секции _____ ИУ4
« _____ » _____ (Индекс)

_____ (И.О.Фамилия)
« _____ » _____ 2013 г.

**ЗАДАНИЕ
на выполнение курсовой работы**

по профилю _____ Технологические процессы микроэлектроники _____

_____ (Тема курсовой работы)

Студент _____
(Фамилия, инициалы, индекс группы)

1. Техническое задание

1.1. Разработать схему электрическую принципиальную устройства, провести моделирование ее работы, а также схему электрическую принципиальную в базе основных логических элементов. 1.2. Разработать документ «Проектные топологические нормы проектируемого кристалла». 1.3. Разработать топологию базовых логических элементов (БЛЭ), входящих в спроектированное устройство. 1.4. Разработать топологию базового матричного кристалла (БМК), изготавливаемого по КМОП технологии. 1.5. Разработать схему размещения БЛЭ на кристалле. 1.6. Разработать комплект конструкторской документации на шаблоны в виде послойных чертежей топологии.

2. Оформление курсовой работы

2.1. Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.
2.2. Перечень графического материала (плакаты, схемы, чертежи и т.п.) _____
2.1. Схема электрическая принципиальная устройства (общая). 2.2. Схема электрическая принципиальная устройства в базе БЛЭ. 2.3. Схема электрическая принципиальная БЛЭ. 2.4. Топологии БЛЭ. 2.5. Совмещенная прорисовка топологии кристалла. 2.6. Схема расположения БЛЭ на кристалле. 2.7. Комплект КД на шаблоны в виде послойных чертежей топологии кристалла. 2.8. Вертикальный профиль спроектированной схемы.

Дата выдачи задания « _____ » _____ 20__ г.

Руководитель курсовой работы

_____ (подпись, дата) _____ (И.О.Фамилия)

Студент

_____ (подпись, дата) _____ (И.О.Фамилия)

Примечание:

1. Задание оформляется в одном экземпляре, который хранится у студента.
2. Итоговая оценка выставляется с учетом оценок, полученных на аттестациях.